

1. 简述：

本芯片采用双极硅外延工艺制造，具有高功率增益放大以及低噪声特性，大动态范围，理想的电流线性；

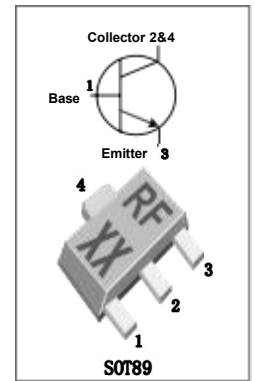
主要应用于射频收发放大、超高频微波、VHF、UHF 和 CATV 等产品上的高频宽带低噪声放大器；

集电极-发射极击穿电压：BVCEO= 15V，最大集电极电流：IC= 150mA；最大集电极耗散功率：PC= 1200mW,特征频率：fT=7.5GHz；

封装形式：SOT89。

直流放大倍数范围对应本体印字：

CLASSIFICATION OF h _{FE}			
Rank	RH	RF	RE
Range	50~100	80~160	125~250
Marking	RH	RF	RE



2. 极限参数 (T_{amb}=25°C)：

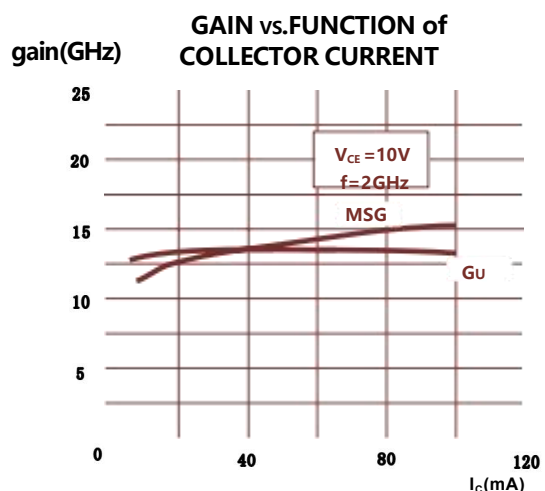
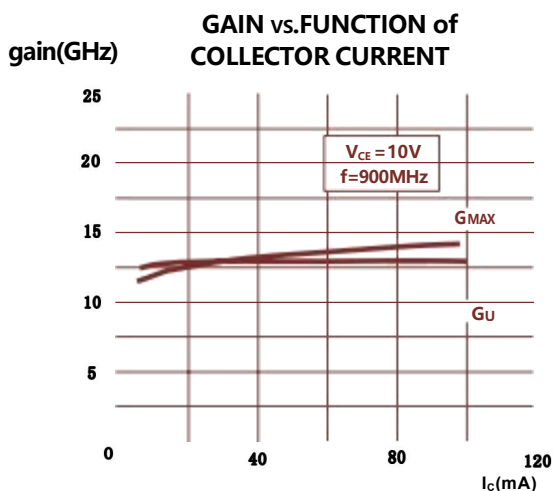
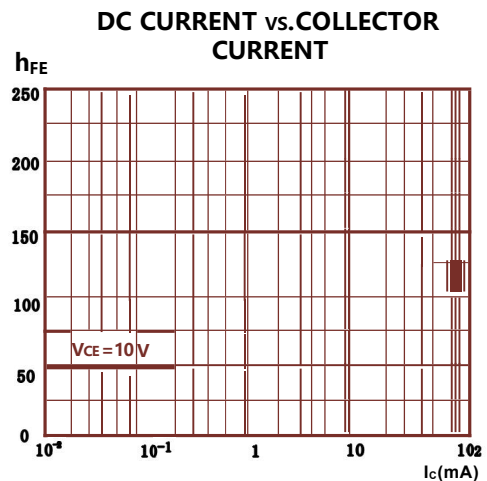
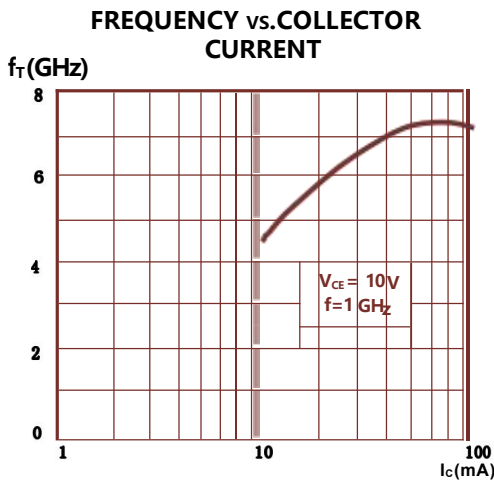
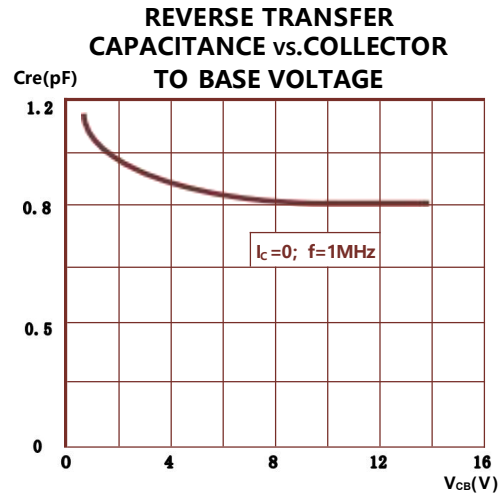
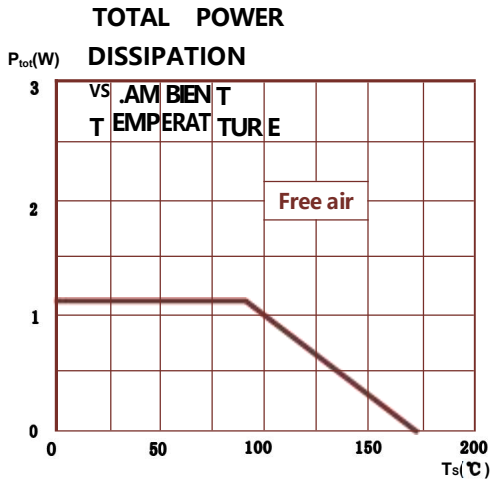
参数名称	符号	额定值	单位
集电极-基极击穿电压	BV _{CBO}	25	V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	15	V
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	3	V
集电极电流	I _c	150	mA
耗散功率	P _T	2000	mW
最高结温	T _J	150	°C
储存温度	T _{stg}	-65 ~ +150	°C

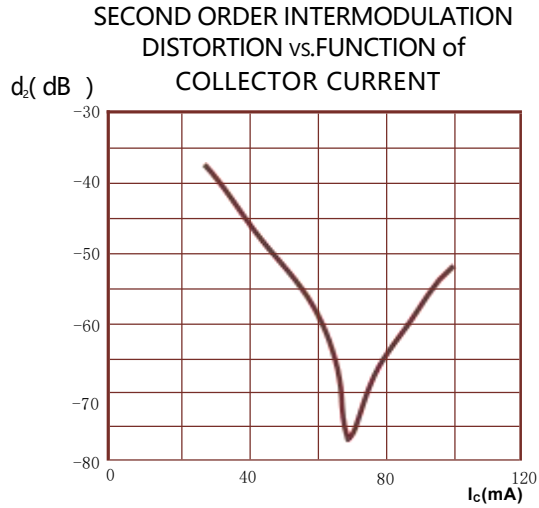
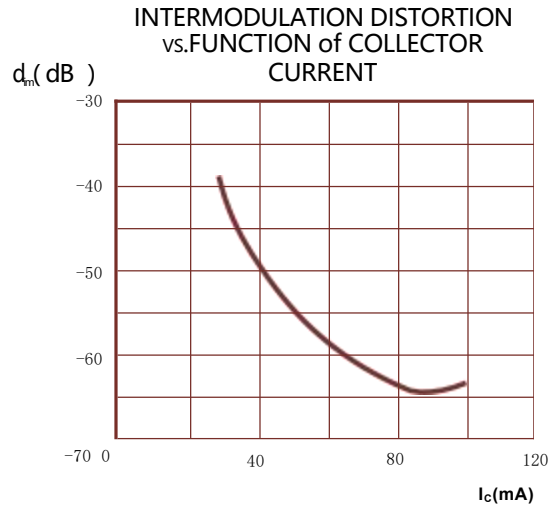
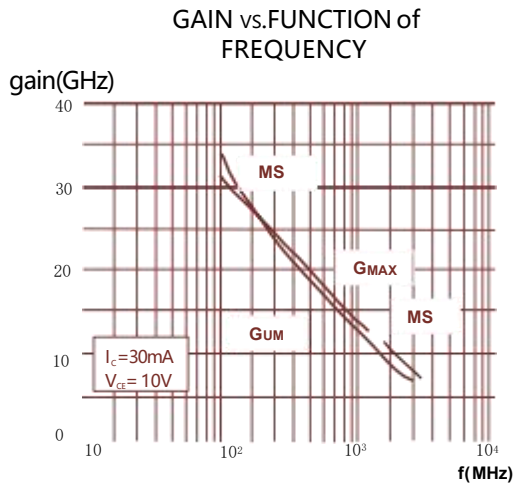
3. 电参数及规格 (T_{amb}=25°C)：

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} = 10V, I _E =0	-	-	1.0	μA
发射极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} = 1.0V, I _C =0	-	-	1.0	μA
直流电流放大系数	h _{FE}	V _{CE} = 10V, I _C =20mA	50	120	250	
特征频率	f _T	V _{CE} = 10V, I _C =20mA	-	7.5	-	GHz
噪声系数	NF	V _{CE} = 10V, I _C =7mA, f= 1.0GHz	-	1.1	-	dB
		V _{CE} = 10V, I _C =40mA, f= 1.0GHz	-	1.8	3.0	dB
反馈电容	C _{re}	I _C =I _E =0, V _{CB} = 10V, f= 1MHz	-	0.65	1.0	pF
插入功率增益	S ₂₁	I _C =20mA, V _{CE} = 10V, f= 1GHz	12.5	13.5	-	dB

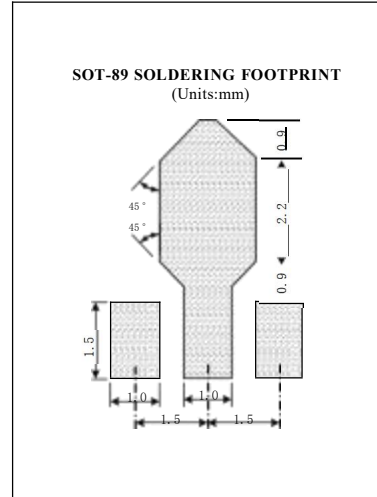
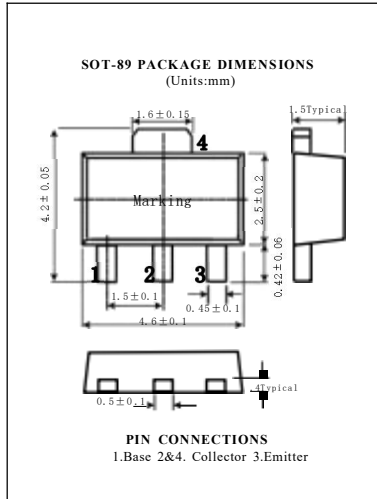
4. 典型特征曲线:

TYPICAL CHARACTERISTICS
($T_A=25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified)





5. 封装尺寸示意图:



6. 包装信息:

PACKAGE INFORMATION

型号	TYPE	封装形式	Package	数量/盘带	Shipping	盘/中盒	Inner Box	中盒/箱	Carton
2SC3357		SOT89		1000	Tape&Reel	4	Tape&Reel	8	Inner Box